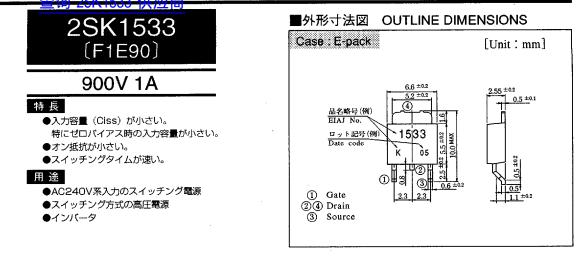
## HVXシリーズ パワーMOSFET HVX Series Power MOSFET



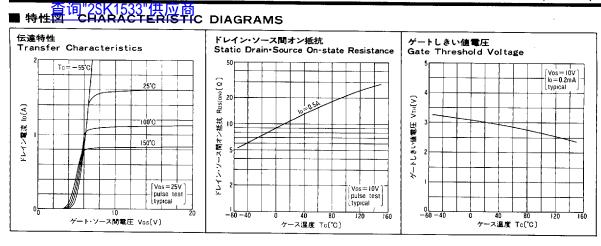
## ■定格表 RATINGS

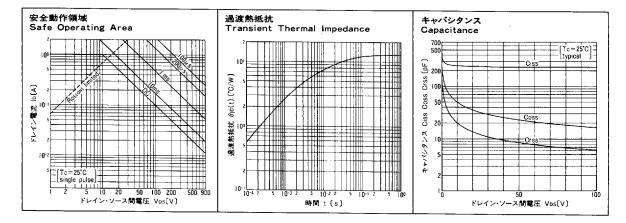
## ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

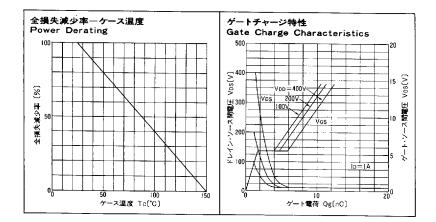
項目記号 Item Symbo		記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature		Tstg		-55~150	°C	
チャネル温度 Channel Temperature		Tch		150	°C	
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage		VDSS		900	v	
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage		VGSS		$\pm 30$	V	
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	ID		1	A	
	Peak	IDP		2		
ソース電流(直流) Continuous Source Current(DC)		Is		1	A	
全損失 Total Power Dissipation		Pr	Tc=25°C	10	W	

## ●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (Tc=25℃)

項目	記号	条件	規格値 Ratings		単位	
ltem	Symbol	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain・Source Breakdown Voltage	$V({\bf B}{\bf R}){\rm D}{\bf S}{\bf S}$	$I_D = 1 m A$ , $V_{GS} = 0 V$	900			v
ドレイン進断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	Idss	$V_{DS}=900V, V_{GS}=0V$			250	μA
ゲート漏れ電流 Gate・Source Leakage Current	Icss	$V_{GS} = \pm 30V,  V_{DS} = 0V$			±100	nA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	gfs	$I_D = 0.5A, V_{DS} = 10V$	0.36	0.6		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain Source On-state Resistance	Rds (ON)	$I_D = 0.5A, V_{CS} = 10V$		11.5	15	Ω
ゲートしきい <b>値電</b> 圧 Gate Threshold Voltage	Vтн	$I_D=0.2mA$ , $V_{DS}=10V$	2	3	4	v
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source・Drain Diode Forward Voltage	VSD	Is=0.5A, $V_{GS}=0V$			1.5	v
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間 junction and case			12.5	℃∕w
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Qg	$V_{GS}=10V, I_D=1A, V_{DD}=400V$		9.1		nC
入力容量 Input Capacitance	Ciss			250		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	Crss	$V_{DS}=10V$ , $V_{GS}=0V$ , $f=1MHz$		20		pF
出力容量 Output Capacitance	Coss			50		pF
ターンオン時間 Turn-on Time	ton	I = 0.5 $M = 10$ $R = 200.0$		40	80	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	toff	$I_D = 0.5 A$ , $V_{GS} = 10 V$ , $R_L = 300 \Omega$		85	170	ns
*		■ 8219387 0002586 793 ■				
236		SHINDENGEN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				







VIII

237

